

Физика и техника полупроводников, 2021, том 55, выпуск 3

Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия) Тыщенко И.Е., Voelskow M., Чжунбинь Сы, Попов В.П. Диффузия атомов In в пленках SiO₂, имплантированных ионами As⁺	217
Электронные свойства полупроводников Дроздов К.А., Крылов И.В., Василик В.А., Косов А.Д., Дубинина Т.В., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р. Эволюция электронного транспорта при резистивных переключениях в пленках порфиразинов	224
Malek S., Pajouh H. Hakimi Impact of an External Magnetic Field on Solitary Waves in Quantum Electron-Hole Plasmas of Semiconductors	229
Поверхность, границы раздела, тонкие пленки Костишин В.Г., Миронович А.Ю., Тимофеев А.В., Исаев И.М., Шакирзянов Р.И., Риль А.И., Сергиенко А.А. Структурные особенности текстурированных пленок оксида цинка, полученных методом ионного распыления	230
Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления Кабанов В.Ф., Михайлов А.И., Гавриков М.В. Исследование электрофизических свойств квантовых точек антимонида индия: значение формы	237
Орлов М.Л., Орлов Л.К. Особенности транспорта электронов в двумерных квантовых сверхрешетках с неассоциативным законом дисперсии	241
Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники Бреев И.Д., Яковлева В.Д., Кудрявцев О.С., Баранов П.Г., Мохов Е.Н., Анисимов А.Н. Спектроскопия комбинационного рассеяния, инфракрасного поглощения и люминесценции нитрида алюминия, легированного бериллием	251
Физика полупроводниковых приборов Шерняков Ю.М., Гордеев Н.Ю., Паюсов А.С., Серин А.А., Корнышов Г.О., Надточий А.М., Кулагина М.М., Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Максимов М.В., Жуков А.Е. Влияние конструкции активной области и волновода на характеристики лазеров на основе структур квантовые ямы-точки InGaAs/GaAs	256
Калыгина В.М., Цымбалов А.В., Алмаев А.В., Петрова Ю.С. Влияние электродов на параметры солнечно-слепых детекторов УФ излучения	264
Алмаев А.В., Николаев В.И., Степанов С.И., Яковлев Н.Н., Печников А.И., Черников Е.В., Кушнарв Б.О. Влияние влажности окружающей среды на электрическую проводимость полиморфных Ga₂O₃-структур	269
Семакова А.А., Романов В.В., Баженов Н.Л., Мынбаев К.Д., Моисеев К.Д. Подавление температурной зависимости длины волны излучения в светодиодных структурах со ступенчатым гетеропереходом II типа InAsSb/InAsSbP	277
Al-Shatravi A.G., Hassan H., Abdulmuhsin S.M., Al-Khursan A.H. TiGaN Quantum-Dot Photodetectors	282
Jayakrishnan R., Raj A., Nair V.G. Deposition of CZTS ZnO Hetero-Junction Using SILAR and Spray Pyrolysis	283
Jalalian D., Ghadimi A., Sar Kaleh A.K.	

Modeling and Simulation of High Efficiency Eco-Friendly Perovskite-CZTSe_{1-x}S_x Solar Cell	284
Jabli F., Dhouibi S., Gassoumi M.	
Improvement in Electrical and 2DEG Properties of Al_{0.26}Ga_{0.74}N GaN Si HEMTs	285
Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур	
Горяева В.Н., Бисенгалиев Р.А.	
Электроосаждение металлов на p-Si из водных электролитов	286
Zhang X.-M., Yan C.-L., Yu G.-H., Zeng C.-H., Sun T.-Y., Xing Z., Wang Y.-Q., Yang J.-H., Zhang B.-S.	
High-Quality Etching of GaN Materials with Extremely Slow Rate and Low Damage	289